



Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

Wrocław, dnia 2023.11.02

Nr Sprawy: PO.2721.122.2023

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław

Przedmiot zamówienia: Wytworzenie pasywowanych tranzystorów typu 2DEG-HEMT

II.

III. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu

IV. Publikacja zapytania ofertowego.

1) Data: **25.10.2023**

2) Adres strony internetowej: - <https://bip.port.org.pl>

V. Termin składania ofert: do dnia 30.10.2023 włącznie.

VI. Wykaz złożonych ofert.

Lp.	Oferent	Cena brutto oferty	Łączna ilość punktów	UWAGI
1	Sieć Badawcza Łukasiewicz-Institut Mikroelektroniki i Fotoniki	129836,34	100	

VII. Wybór oferty.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Institut Mikroelektroniki i Fotoniki
Al.Lotników 32/46
02-668 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wymagania i jest najkorzystniejsza cenowo.

.....
(Podpis osoby upoważnionej)

Sporządziła: Anna Kaszuba



Projekt pn. „Wysokowydajne tranzystory AlGaIn/GaN-HEMT wykonywane hybrydową technologią MBE-MOVPE” dofinansowano ze środków budżetu państwa, dotacja celowa przyznawana instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz na podstawie umowy nr 2/Ł-PORT/CŁ/2021

Strona 1 z 1

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 356893841
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580